ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУБНА

P2 - 7220

С.В.Голоскоков

4044 273

АНАЛИЗ

346.2

F-616

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО СЕЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРА НАКЛОНА ДИФРАКЦИОННОГО ПИКА РР - РАССЕЯНИЯ В КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОДХОДЕ





P2 - 7220

С.В.Голоскоков

АНАЛИЗ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО СЕЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРА НАКЛОНА ДИФРАКЦИОННОГО ПИКА РР - РАССЕЯНИЯ В КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

Направлено в ЯФ

В настоящей работе мы изучим асимптотическое поведение полного сечения и параметра наклона дифракционного пика высокоэнергетического *Pp* -рассеяния в рамках квазипотенциального подхода Логунова-Тавхелидзе ^{/1/}.

Обсудим сначала экспериментальную ситуацию. Новые экспериментальные данные по *PP* - рассеянию указывают на рост полных сечений $^{/2'}$, обработка данных по σ_{tot}^{pp} , проведенная в этих работах, показала, что при $s \ge \ge 50 / \Gamma$ эв/с/²

$$\sigma_{tot}^{pp} - c + d(\ln s), \qquad (1/$$

причем а - 2.

В связи с этим в препринтах^{/3,4/} обсуждается случай роста полных ссчений максимально возможным образом *:

$$\sigma_{tot}^{PP} \sim \ln^2 s$$
 nph $s \rightarrow \infty$, /2/

В них показано, что в этом случае параметр наклона дифракционного пика также должен расти максимально возможным образом:

$$B^{pp} \sim \ln^2 s \,. \qquad (3)$$

Однако экспериментальные данные указывают на замедление скорости роста параметра наклона дифракционного пика в области энергий s > 150 /Гэв/с/^{2//}

^{*} В рамках квантовой теорин поля получены ограничення сверху на рост полного сечения рассеяния σ_{tot} ≤ ≤ ln² s^{/5}/ и параметра наклона днфракционного пика В ≤ ln² s^{/6}/.

В связи с этим вызывает интерес более детальный анализ поведения σ_{tot}^{pp} и В^{pp} при высоких энергиях.

Мы провели анализ экспериментальных данных для *pp*-рассеяния при $s \ge 15 / \Gamma \operatorname{эn/c/}^2$, исходя из следующих эмпирических соотношений для σ_{tot}^{pp} и B^{PP} :

$$\sigma_{tot}^{PP} = \sigma_0 + \sigma_1 / \sqrt{s} + \sigma_2 (ln (s/s_0))^a, \qquad /4a/$$

$$B^{PP} = b_0 + b_1 / \sqrt{s} + b_2 (ln (s/s_0))^b, \qquad (s_0 - 1(GeV/c)^2) \qquad /46/$$

Параметры, соответствующие наилучшему описанию по критерию χ^2 , н величины χ^2/N , где N - число рассмотренных экспериментальных точек, приведены в табл. 1 и 2.

Как видно из табл. !, хорошее описание экслериментальных данных по σ_{tot}^{pp} может быть получено при а, изменяющихся в широком интервале:

 $a = -1 \div +2$

Таким образом, имеющийся к настоящему времени экспериментальный материал по полным сечениям *pp* расссяния не позволяет сделать заключения о характерс асимптотического поведения σ_{tot}^{pp} при больших *s*. Полное сечение σ_{tot}^{pp} может как неограниченно возрастать при $s \rightarrow \infty (a > 0)$, так и стремиться к постоянному пределу снизу (a < 0).

Из табл. 2 видно, что параметр наклона дифракционного пика B^{pp} может неограниченно возрастать, как \sqrt{lns} , однако стремление снизу к постоянному пределу несколько предпочтительнее.

Займемся теперь исследованием поведения о_{tot} и В при высоких энергиях в рамках квазипотенциального подхода. Основой нашего рассмотрения будет гладкий ^{ду/} локальный квазипотенциал гауссовского типа:

$$V(s,r) = is g(s)(\frac{\pi}{a(s)}) = \frac{3/2}{c} - r^{2}/4e(s)$$
 /5/

	Таблица	I

a _o '		σι	<i>o</i> ₂ .	χ ² /N	
2	32,51±0,41	28,15 <u>+</u> 2,02	0,I48±0.00I	0,62	
I	24,56 <u>+</u> 0,87	41,63 <u>+</u> 2,77	2,12 ± 0,13	0,76	
-0,5	84 ,56<u>+</u>2, 7I	127 ,81<u>+</u>7,7 8	-I26,37 <u>+</u> 7,53	0,74	
-I	76,3 <u>+</u> 2,28	304 ,5 4 <u>+</u> 18,75	-314,79 <u>+</u> 19,37	0,76	

S

. .

Табляца 2

β	ь ₀	<i>b</i> ₁ ;	<i>b</i> 2	χ^2/N	
2	9,74±0,06	0	0,06± 0,002	3,16	
I	8,15 <u>+</u> 0,1	0	0,63+ 0,02	I,44	
0,5	4 , 99 <u>+</u> 0,2	0	2,84 <u>+</u> 0,I	1, 11	
-0,5	17,49 <u>+</u> 0,22	0	-13,62+0,48	0,8	
-I	I4,34 <u>+</u> 0,II	0	-I4,57 <u>+</u> 0,52	0,84	
	I2,6 <u>+</u> 0,05	-I4,09 <u>+</u> 0,5	0	0,91	

В работах /10/ показано, что квазипотенциал /5/ позволяет правильно передать общую картину pp-рассеяния при высоких энергиях.

Полное сечение рассеяния и параметрнаклона дифракционного пика выражаются через параметры квазипотенциала /5/ следующим образом:

$$\sigma_{tot} = 8\pi a I(x), \qquad /6a/$$

$$B = 2a J(x) / I(x),$$
 /65/

где

$$I(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^{n}}{nn!} \approx \int_{0}^{x} \frac{d\xi}{\xi} (1 - e^{-\xi}), \qquad /7a/$$

$$J(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^{n}}{n^{2}n!} = \int_{0}^{x} \frac{d\xi}{\xi} I(\xi), \qquad /76/$$

$$x = 4\pi^{2} g/a. \qquad /76/$$

Определим величину D, зависящую от х следующим образом:

$$D(x) = \frac{\sigma_{tot}}{4\pi B} = \frac{I^{2}(x)}{J(x)}, \qquad /8/$$

Можно показать, что для любых х величина Dorраничена сверху:

$$D(x) = \frac{\sigma_{tot}}{4\pi B} \le 2.$$

Это ограничение справедливо для широкого класса гладких локальных квазипотенциалов экспоненциального вида.

Из /9/ следует, что для гладких квазипотекциалов

полное сечение рассеяния не может расти быстрее параметра наклона днфракционного пика.

$$\sigma_{tot} \le 8\pi B. \qquad /10/$$

Отметим, что исходя из строгих ограничений сверху на $B^{/6/}$ и сиизу на амплитуду рассеяния в область большьх углов $^{/1}$ полученных в квантовой теории поля, можно получить ограиичения сверху на параметры квазилотенциала $^{/12/}$:

Следовательно, параметр × может растн степенным образом при з→∞, причем

$$x < \sqrt{s}$$
. /11B/

Исследуем теперь асныптотическое поведение σ_{tot} и В при различном поведении параметра х в случае $s \rightarrow \infty^{-1/2} s^{4/2}$.

А. Если $x \rightarrow 0$ при $s \rightarrow \infty$,

$$D(\mathbf{x}) = \frac{\sigma_{tot}}{4\pi B} \to 0, \qquad /12a/$$

- $\sigma_{tot} \sim 8\pi a x$, /126/
- B~2a. /12B/
- **Б.** Если $x \rightarrow c = const$,

$$D(x) = \frac{\delta_{tot}}{4\pi B} \rightarrow const < 2, \qquad /13a/$$

$$\sigma_{tot} \simeq 8\pi a \ I(c), \qquad /136/$$

$$B \simeq 2 \ a \ J(c)/I(c). \qquad /13B/$$

$$B. \ ECJH \ x \rightarrow \infty \ \Pi pH \ s \rightarrow \infty, \qquad$$

$$D(x) = \frac{\sigma_{tot}}{4\pi B} \rightarrow 2, \qquad /14a/$$

$$\sigma_{tot} \simeq 8\pi a \ ln \ x, \qquad /146/$$

 $B \simeq a \ln x$. /14B/

Из приведенных выше соотношений /14/ следует, что полное сечение рассеяния может расти максимально возможным образом /2/ только в случае

при этом

$$\sigma_{tot} = 8\pi B - ln^2 s$$
. /16/

Определим теперь завнсимость параметров g, а н х от энергин, используя экспериментальные данные по полному сечению и параметру наклона дифракционного пика pp -рассеяния и соотношения /8/ и /6а/ или /6б/.

Полученные параметры g, a, x при различных энергиях приведены на рис. 1 и 2. Из рисунков видно, что параметр a(s) монотонно растет с энергией, а параметр g(s)(x(s)) сначала медленно убывает до энергии $s \sim 200 / \Gamma \text{ зв/с/}^2$, а затем начинает расти. Естественно, характер этого роста при существующих энергиях определить невозможно.

Для того, чтобы описать полученную зависимость параметров квазипотенциала от энергии, мы использовали несколько моделей, отличающихся друг от друга различной параметризацией энергетической зависимости a(s) и g(s):

/1/

$$a(s) = a_0 + a_1 / \sqrt{s}$$
, /17a/

$$g(s) = g_0 + g_1 / \sqrt{s} + g_2 / \sqrt{\ln(s/s_0)}$$
. /176/

Здесь и далее

$$s_0 = 1 / \Gamma \mathfrak{I} \mathfrak{B} / \mathfrak{c} / 2$$
.

~

При этом

$$\sigma_{tot} \sim B \sim \sigma_0 + \sigma_1 / \sqrt{s} + \sigma_2 / \sqrt{\ln(s/s_0)} + \dots / 17 B/$$

/11/

$$a(s) = a_0 + a_1 / ln(s/s_0),$$
 /18a/

$$g(s) = g_0 + g_1 / \sqrt{s} + g_2 \ln(s/s_0),$$
 /186/

$$\sigma_{tot} \sim B \sim \sigma_0' \ln \ln(s/s_0) + \sigma_0 + \sigma_1/\sqrt{s} + \sigma_2/\ln(s/s_0) + \dots / 18B/$$

/111/

$$a(s) = a_0 + a_1 / ln(s/s_0),$$
 /19a/

$$g(s) = g_0 + g_1 / \sqrt{s} + g_2 \ln^2(s/s_0),$$
 /196/

при этом для асниптотического поведения σ_{tot} и В справедливо выражение /18в/ /1V/

$$a(s) = a_0 + a_1 \sqrt{ln(s/s_0)};$$
 /20a/

$$g(s) = g_0 + g_1 / \sqrt{s} + g_2 \ln(s/s_0),$$
 /206/

$$\sigma_{tot} \sim B \sim \sigma_0' \sqrt{\ln(s/s_0)} + \sigma_0 + \sigma_1' \sqrt{s} + \sigma_2' \sqrt{\ln(s/s_0)} + \dots /20B/$$

Параметры, соответствующие нанлучшему описанию экспериментальных данных по σ_{tot}^{pp} и $B^{pp'}$ в области энергий $s \ge 15 / \Gamma \mathfrak{IB} / c/^2 \mathfrak{n}$ вычисленные отношения χ^2 / N приведены в табл. З. Как видно, во всех случаях /1- \mathbb{N} / u меется хорошее описание экспериментальных данных. Полученные теоретические кривые для σ_{tot}^{pp} и B^{pp} приведень на рис. З,4. На рис. 1 и 2 показана зависимость параметров квазилотенциала от энергии / вариант /11//.

Таким образом, существующие в настоящее время экспериментальные данные по σ_{lot}^{pp} н B^{pp} не позволяют определить асимптотическое поведение параметров квазипотенциала при $s \rightarrow \infty$, При этом поведение σ_{lot}^{pp} и B^{pp} при высоких энергиях может быть весьма различным /17в, 18в, 2ОВ/. Однако при достигнутых энергиях полные сечения растут, по всей видимости, медленнее квадрата логарифма.

Отметим, что близкие результаты могут быть получены в ряде моделей эйконального типа.

В заключение автор выражает глубокую благодарность В.А.Матвееву, А.Н.Тавхелидзе, Д.В.Ширкову за интерес к работе и критические замечания, а также А.А.Архипову, В.Р.Гарсеванишвили, А.В.Ефремову, С.П.Кулешову, Р.М.Мурадяну, В.И.Саврину, А.Н.Сисакяну, Л.А.Слепченко, М.А.Смондыреву, Н.Е.Тюрину, О.А.Хрусталеву за полезные обсуждения.

Литература

- I. A.A.Logunov, A.N.Tavkhelidze. Nuovo Cim., 29, 380 (1963).
- U.Amaldi, R.Biancaslelly et al. I.V.Allaby et al.; S.R.Amendolia, G.Bellettini et al. Preprints CERN, Geneva, 1973.
- A.A.Logunov, O.A.Khrustalev, M.A.Mestvirishvili, Preprint IHEP, STF-73-25, Serpukhov, 1973.
- A.A.Arkhipov, V.I.Sevrin, N.E.Tyurin, O.A.Khrustelev. Preprint IHEP STF-73-26, Serpukhov, 1973.
- 5. M Froissert. Phys.Rev., 123, 1053 (1961).

- A.A.Logunov, M.A.Mestvirishvili, Nguyen van Hieu. Phys.Lett., 258, 611 (1967);
 T.Kinoshita. Lectures in Theoretical Physics, 7B, 144. Univ. Colorado Press, 1964.
- M.Holder et al. Phys.Lett., 35B, 355 (1971);
 36B, 401 (1971);
 U.Amaldi et al. Phys.Lett., 36B, 504 (1971);
 G.Barbliellini et al. Phys.Lett., 39B, 663 (1972).
- 8. S.P.Alliluyev, S.S.Gershtein, A.A.Logunov. Phys.Lett., 18, 195 (1965).
- А.А. Лоѓунов, О.А. Хрусталев. ЭЧАЯ, том. 1, вып. 1, спр. 71, Атомиздат, Москва, 1970; В.М.Ваrbashov, S.P.Kuleshov, V.А.Matveev, A.N.Sissakian, A.N.Tavkhelidze. Phys.Lett., 33B, 419 (1970).
- V.R.Garsevenishvili, V.A.Matveev, L.A.Slepchenko, A.N.Tavkhelidze. Phys.Rev., 4D, 849 (1971);
 B.P.Гаргеванишвили, В.А.Матвеев, Л.А.Слепченко. ЭЧАЯ, т. 1, вып. 1, стр. 91, Апомиздап, Москва, 1970.
- II. A.A.Logunov, M.A.Mestvirishvili. Phys.Lett., 24B, 583 (1967).
- 12. С.В.Голоскоков, В.А.Матвеев. ЯФ, 16, 1297 /1972/.

Рукопись поступила в издательский отдел 4 июня 1973 года,

Таблица	3
---------	---

Вариант	a0 ,	a ₁	Ê ₀	é ₁	é ₂	a pp s=00.	B ^{pp} s=∞	χ^2/N
I	5,723 ±0,027	-7,192 +0,258	0,323 20,011	0,622 <u>+</u> 0,033	-0,560 ±0,031	א3ע 90	I5(Gev.) ²	0 ,77
8	6,6II ±0,058	-7,439 <u>+</u> 0,266	0,059 ±0,004	0,234 ±0,0I3	0,009 ±0,0006	<i>`</i> æ	00	0,73
	6,610 ±0,058	-7,434 +0,265	0,09I ±0,002	0,186 <u>+</u> 0,008	7,1*10 ⁻⁴ ±2.7*10 ⁻⁵	~	~	0,78
ינו	1,875 ±0,115	I,436 ±0,052	0,066 <u>+</u> 0,003	0,207 ±0,0II	0,008 ±5#10 ⁻⁴	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~	I,04









.